

■ **パワートランジスタ (モールドタイプ) Power Transistors (Molded types)**

超高速スイッチングトランジスタ High speed switching transistors

形式 Device type	V _{CB0} Volts	V _{CEO} Volts	I _c Cont. Amps.	P _c Watts	h _{FE} (Min.)	I _c		スイッチングタイム ton μsec.	Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						Amps.	V _{CE} Volts		tstg μsec.	tf μsec.			
2SC2438	150	80	7	50	60	1	1	0.5	2.5	0.3	TO-220AB	2.0	
2SC2767	250	200	5	40	20	1	5	1.0	2.0	1.0	TO-220AB	2.0	
2SC2768	250	200	6	40	20	1	5	1.0	2.0	1.0	TO-220AB	2.0	
2SC2769	250	200	10	100	20	2	5	0.8	2.0	0.5	TO-3P	5.5	
2SC2944	250	200	15	100	20	2	5	0.8	1.5	0.4	TO-3P	5.5	
2SC2626	400	300	15	80	10	6	5	0.8	2.0	0.8	TO-3P	5.5	
2SC2929	450	400	3	40	20	0.5	5	1.5	2.0	0.8	TO-220AB	2.0	
2SC2542	450	400	5	40	10	2	5	1.0	2.0	1.0	TO-220AB	2.0	
2SC3723	450	400	5	40	10	2	5	1.0	2.5	0.5	TO-220AB	2.0	
2SC3317	500	400	5	40	10	2	5	0.5	1.5	0.15	TO-220AB	2.0	
2SC4242	450	400	7	40	10	4	5	1.0	2.5	0.5	TO-220AB	2.0	
2SC4622	500	400	7	50	10	4	5	1.0	2.5	0.5	TO-220AB	2.0	
2SC2625	450	400	10	80	10	4	5	1.0	2.0	1.0	TO-3P	5.5	
ET405R	450	400	10	80	10	4	5	1.0	2.0	1.0	TO-3PF	6.0	
2SC3318	500	400	10	80	10	5	5	0.5	1.5	0.15	TO-3P	5.5	
ET400	500	400	10	80	10	5	5	0.5	1.5	0.15	TO-3PF	6.0	
2SC3320	500	400	15	80	10	6	5	0.5	1.5	0.15	TO-3P	5.5	
ET401R	500	400	15	80	10	6	5	0.5	1.5	0.15	TO-3PF	6.0	
2SC3047	850	500	6	40	15	0.5	5	1.0	3.0	1.0	TO-220AB	2.0	
ET206	850	500	10	80	15	1	5	1.0	3.5	1.0	TO-3P	5.5	

ウルトラハイβトランジスタ Ultra high β transistors

形式 Device type	V _{CB0} Volts	V _{CEO} Volts	I _c Cont. Amps.	P _c Watts	h _{FE} (Min.)	I _c		スイッチングタイム ton μsec.	Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						Amps.	V _{CE} Volts		tstg μsec.	tf μsec.			
2SD1158	80	50	8	40	250	1	5	0.5	3.0	0.8	TO-220AB	2.0	
2SD1118	80	50	10	50	300	1	5	0.5	3.0	0.8	TO-220AB	2.0	
2SD1128	150	100	5	30	700	1	4	-	-	-	TO-220AB	2.0	
2SD923	150	100	10	80	700	3	4	-	-	-	TO-3P	5.5	
2SD982	200	180	5	40	700	1	4	-	-	-	TO-220AB	2.0	
2SD921	200	180	5	80	700	1	4	-	-	-	TO-3P	5.5	

記号 Letter symbols

V _{CB0} :	コレクタ・ベース間電圧	Collector-to-base voltage (Emitter open)
V _{CEO} :	コレクタ・エミッタ間電圧	Collector-to-emitter voltage (Base open)
V _{CEO (sus)} :	コレクタ・エミッタ間電圧	Collector-to-emitter sustaining voltage (Base open)
V _{CEX (sus)} :	コレクタ・エミッタ間電圧	Collector-to-emitter sustaining voltage (Base reverse bias)
I _{c (cont)} :	コレクタ電流	Collector-current (continuous)
P _c :	コレクタ損失	Maximum power dissipation
h _{FE} :	直流電流増幅率	DC current gain
ton:	ターンオン時間	Turn-on time
tstg:	蓄積時間	Storage time
tf:	立上り時間	Fall time

■ パワートランジスタ (モールドタイプ) Power Transistors (Molded types)

パワーダーリントントランジスタ Power darlington transistors

形式 Device type	VCBO Volts	VCEO Volts	Ic Cont. Amps.	Pc Watts	hFE (Min.)	hFE		スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						Ic Amps.	VCE Volts	ton μ sec.	tstg μ sec.	tf μ sec.		
2SD833	60	60	7	40	4000	3	3	-	-	-	TO-220AB	2.0
2SD916	60	60	7	30	800	3	1.5	-	-	-	TO-220AB	2.0
ET378	100	100	10	80	1000	6	2	-	-	-	TO-3P	5.5
2SD834	250	200	4	25	1500	2	2	1.7	15.0	18.0	TO-220AB	2.0
2SD1073	300	250	4	60	1000	2	2	-	-	-	TO-220AB	2.0
2SD835	400	400	6	40	400	4	1.5	1.0	12.0	6.0	TO-220AB	2.0
2SD1072	450	450	5	60	500	3	1.5	1.5	12.0	6.0	TO-220AB	2.0
2SD1071	450	300 *	6	40	500	4	2	-	-	-	TO-220AB	2.0
ET375	650	450	15	80	100	15	5	1.0	12.0	2.0	TO-3P	5.5
ET190	600	600	8	80	200	5	5	1.5	15.0	1.5	TO-3P	5.5
ET191	600	600	12	100	100	12	5	1.5	10.0	2.0	TO-3P	5.5

* Vz ツェナー電圧

大電流高速スイッチングトランジスタ High current switching transistors

形式 Device type	VCBO Volts	VCEO (sus) Volts	Ic Cont. Amps.	Pc Watts	hFE (Min.)	hFE		スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						Ic Amps.	VCE Volts	ton μ sec.	tstg μ sec.	tf μ sec.		
ET188	400	300	100	600	200	100	5	2.0	12.0	3.0	BBT II	145

RCC用トランジスタ High speed switching transistors for ringing choke converter

形式 Device type	VCBO Volts	VCEO Volts	Ic Cont. Amps.	Pc Watts	hFE (Min.)	hFE		スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						Ic Amps.	VCE Volts	ton μ sec.	tstg μ sec.	tf μ sec.		
2SC4273	500	400	5	40	25	0.5	5	1.0	2.5	0.5	TO-220AB	2.0
2SC4274	500	400	10	40	25	1	5	1.0	2.5	0.5	TO-220AB	2.0
2SC4275	500	400	10	80	25	1	5	1.0	2.5	0.5	TO-3P	5.5
2SC4509R	500	400	10	80	25	1	5	1.0	2.5	0.5	TO-3PF	6.0
2SC4276	500	400	15	80	25	2	5	1.0	2.5	0.5	TO-3P	5.5
2SC4510R	500	400	15	80	25	2	5	1.0	2.5	0.5	TO-3PF	6.0

ラージSOAトランジスタ Large SOA switching transistors

形式 Device type	VCBO Volts	VCEO Volts	Ic Cont. Amps.	Pc Watts	hFE (Min.)	hFE		スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						Ic Amps.	VCE Volts	ton μ sec.	tstg μ sec.	tf μ sec.		
2SC2656	450	400	7	80	10	3	4	1.5	3.0	1.5	TO-3P	5.5

低耐圧大電流スイッチングトランジスタ Low voltage high current switching transistors

形式 Device type	VCBO Volts	VCEO Volts	Ic Cont. Amps.	Pc Watts	hFE (Min.)	hFE		スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						Ic Amps.	VCE Volts	ton μ sec.	tstg μ sec.	tf μ sec.		
2SD1049	120	80	25	80	20	25	5	1.0	2.5	0.4	TO-3P	5.5

■ パワートランジスタ (モールドタイプ) Power Transistors (Molded types)
高耐圧高速スイッチングトランジスタ High voltage high speed switching transistors

形式 Device type	V _{CB0} Volts	V _{CEO} Volts	I _c Cont. Amps.	P _c Watts	h _{FE} (Min.)	I _c		V _{CE} Volts	スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						I _c Amps.	V _{CE} Volts		t _{on} μ sec.	t _{stg} μ sec.	t _f μ sec.		
2SC3549	900	800	3	40	10	1	5	1.0	4.0	0.8	TO-220AB	2.0	
2SC3550	900	800	3	80	10	1	5	1.0	4.0	0.8	TO-3P	5.5	
2SC4603R	900	800	3	80	10	1	5	1.0	4.0	0.8	TO-3PF	6.0	
2SC3551	900	800	5	80	10	2	5	1.0	4.0	0.8	TO-3P	5.5	
2SC4538R	900	800	5	80	10	2	5	1.0	4.0	0.8	TO-3PF	6.0	
2SC4419	900	800	6	100	10	2	5	1.0	4.0	0.8	TO-3P	5.5	
2SC3030	900	800	7	80	8	3	5	0.5	2.5	0.8	TO-3P	5.5	
2SD2047R	1500	1500 *	5	80	18	1	5	1.0	3.0	0.5	TO-3PF	6.0	

* V_{CEs}

ドライブ用パワートランジスタ Buffer drive transistors

形式 Device type	V _{CB0} Volts	V _{CEO} Volts	I _c Cont. Amps.	P _c Watts	h _{FE} (Min.)	I _c		V _{CE} Volts	スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						I _c Amps.	V _{CE} Volts		t _{on} μ sec.	t _{stg} μ sec.	t _f μ sec.		
2SC3047	850	500	6	40	15	0.5	5	1.0	3.0	1.0	TO-220AB	2.0	
ET206	850	500	10	80	15	1	5	1.0	3.5	1.0	TO-3P	5.5	
ET191	600	450 *	12	100	100	12	5	1.5	10.0	2.0	TO-3P	5.5	
2SC3549	900	800	3	40	10	1	5	1.0	4.0	0.8	TO-220AB	2.0	
2SC3551	900	800	5	80	10	2	5	1.0	4.0	0.8	TO-3P	5.5	
ET383	1000	800	5	80	10	2	5	1.0	4.0	0.8	TO-3P	5.5	

* V_{CEO(sus)}

一般用パワートランジスタ General use transistors

形式 Device type	V _{CB0} Volts	V _{CEO} Volts	I _c Cont. Amps.	P _c Watts	h _{FE} (Min.)	I _c		V _{CE} Volts	スイッチングタイム Switching time (Max.)			パッケージ Package	質量 Net mass Grams
						I _c Amps.	V _{CE} Volts		t _{on} μ sec.	t _{stg} μ sec.	t _f μ sec.		
2SD847	40	40	15	80	40	5	2	1.0	2.0	1.0	TO-3P	5.5	
2SD1157	80	50	4	25	250	0.5	5	0.5	3.0	0.8	TO-220AB	2.0	
ET393R	150	100	10	80	700	3	4	-	-	-	TO-3PF	6.0	
2SC2440	450	400	5	40	15	2	5	1.5	4.0	1.3	TO-220AB	2.0	